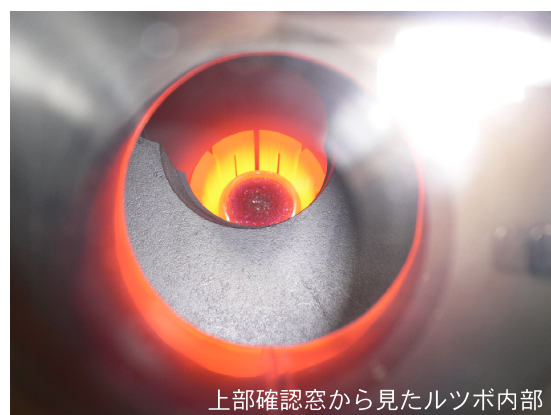


シリコン単結晶引き上げ装置

型式：TCR-5C / TCR-15C

特長

1. 実験・研究用の小型シリコン単結晶育成装置(CZ法)です。
2. ステンレス製缶体内は、アルゴンガス雰囲気制御します。
3. 発熱体はカーボンヒーターによる、抵抗加熱式です。
4. 炉内の温度制御は熱電対制御方式です。



上部確認窓から見たルツボ内部

構成

1. 単結晶引き上げ炉
2. 制御盤
3. 手元装置ボックス
4. 電源ボックス

仕様

型式名称	TCR-5C	TCR-15C
ルツボ寸法	φ3in, × 3in,	φ6in, × 6in,
試料チャージ量	350g	2500g
加熱方式	抵抗加熱式 (カーボンヒーター)	
引き上げ軸ストローク	500 mm	1200 mm
引上軸移動速度	0.5~3 mm/分	
引上軸回転速度	2.0~20 rpm	
ルツボ軸ストローク	100 mm	
ルツボ軸移動速度	0.1~1 mm/分	
ルツボ軸回転速度	1~8 rpm	
缶体サイズ	φ350×L500mm	φ450×L600mm
設備電源容量	25 kVA	45kVA



結晶成長装置の専門メーカー



株式会社 テクノサーチ

〒206-0012 東京都多摩市貝取1-60-5 TEL:042-339-1172 FAX:042-357-3911
web site : <http://techno-search.co.jp/> E-Mail : fvgv1120@mb.infoweb.ne.jp

〒651-1211 兵庫県神戸市北区小倉台6-13-16 TEL/FAX:078-582-3782
E-Mail : fvgv1121@mb.infoweb.ne.jp

※本製品は性能向上のため予告なしに形状及び仕様を変更することがあります。